14

METAL COMPLEX, INFRARED-ABSORBING AGENT AND FILTER FOR PLASMA DISPLAY

Patent number: JP2000159776
Publication date: 2000-06-13

Inventor: OZAWA TETSUO; SHIMIZU KANJI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

C07F1/08; C09K3/00; G02B1/10; G02B5/22

- european:

Application number: JP19980337354 19981127
Priority number(s): JP19980337354 19981127

Report a data error here

Abstract of JP2000159776

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new metal complex having near infrared absorbency and sultably applicable to a near infrared absorbent and filter for plasma display panel. SOLUTION: This metal complex is a complex of a squalifum compound of formuta I (Wherein, R1 and R1 are each H, an alklylarmino, a dialkylarmino, a cycloalkylarmino or the like; X and X' are each a group having active hydrogen; rings A and B are each an aromatic carbocycle or an aromatic heterocycle; (k) and (k') are each 1.4], [preferably a compound of formula II (wherein, R2-R4 are each H, an alkly, a cycloalkylor of the like)] with a metal (preferably copper, cobalt, zinc or nickel). The metal complex is obtained by reacting the sequalirium compound of formula I with a metal source in an organic solvent. The metal complex has absorbency in a near infrared region of 700-950 nm and can manifest excellent effect as coloring matter for writing in or readout in optically recording media using semiconductor laser or the like and liquid crystal displays, or the like.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-159776 (P2000-159776A)

(P2000-159776A) (43)公開日 平成12年6月13日(2000.6.13)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
C07F	1/08		C 0 7 F	1/08	В	2H048
C 0 9 K	3/00	105	C09K	3/00	105	2K009
G 0 2 B	1/10		G 0 2 B	5/22		4H048
	5/22			1/10	Z	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 8 頁)

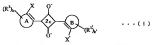
(21)出顧番号 特顧平10-337354	(71)出願人 000005968
	三菱化学株式会社
(22)出顧日 平成10年11月27日(1998.11.27)	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
	(72)発明者 尾澤 鉄男
	神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
	三菱化学株式会社横浜総合研究所内
	(72)発明者 清水 完二
	神奈川県横浜市青業区鳴志田町1000番地
	三菱化学株式会社横浜総合研究所内
	(74)代理人 100103997
	弁理士 長谷川 噪司
	升程工 安台川 見可

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 金属錯体、これを含む近赤外線吸収剤及びプラズマディスプレイパネル用フィルター

(57) 【要約】

【課題】 近赤外線吸収能を有し、特にプラズマディス プレイパネル用のフィルターに好適に使用される、新し い化合物を提供する。 【解決手段】. 透明基板上に、下記一般式(I)で表されるスクアリリウム系化合物と金属との錯体。 【化1】



(式中、R¹、R¹′は、水素原子、置換基を有していても良いアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、シウアルキルアミノメ、アルコキシ基を表し、X、X′は活性水素を有する基を表し、環A、環日は芳香族炭素環

または芳香族複素環を表し、kは1~4の整数を表す。 XとX′とは互いに連結して、5又は6員の環を形成しても良い。)

【特許請求の節用】

【請求項1】 下記一般式(I)で表されるスクアリリ

$$(R^{i})_{k} \xrightarrow{X} 0$$

$$(R^{i})_{k'} \qquad \cdots (1)$$

(式中、 R^1 、 R^1 ′は、同じまたは異なって、水素原 子、置換基を有していても良いアルキルアミノ基、置換 基を有していても良いジアルキルアミノ基、置換基を有 していても良いシクロアルキルアミノ基、置換基を有し ていても良いアルコキシ基を表し、X、X'は、同じま たは異なって、活性水素を含有する基を表し、環A、環 Bは、それぞれ独立して、芳香族炭素環または芳香族複 素環を表し、k、k'は1~4の整数を表す。また、X とR¹、X'とR¹'は、それぞれ独立して、互いに連 結して5又は6員の環を形成しても良い。)

【請求項2】 錯体を構成する金属が、銅、コパルト、 亜鉛、ニッケルから選ばれることを特徴とする請求項1 記載の錯体。

【請求項3】 スクアリリウム系化合物が、下記一般式 (11) で表される化合物であることを特徴とする請求項 1又は2記載の錯体。

【化2】

(式中、R² 、R³ 、R⁴ は、それぞれ独立して、水素 原子、置換基を有していても良いアルキル基、置換基を 有していても良いシクロアルキル基、置換基を有してい ても良いアリール基又はヘテロアリール基を表し、R2 とR3 或いはR3とR4 は互いに連結して5又は6員の 環又は環の1部を形成しても良い。)

【請求項4】 スクアリリウム系化合物が、一般式 (I において、R² が水素原子で、R³、R⁴ がアルキ ル基であるか、或いはR3 とR4 が連結して置換シクロ アルキリデン基であることを特徴とする請求項3記載の 錯体。

【請求項5】 スクアリリウム系化合物が、一般式(I において、R² が水素原子で、R³、R⁴ が置換基 としてアリール基、アリールオキシ基、アルカノイルオ キシ基を有していても良いアルキル基、アリール基また はフリル基から選ばれる基であることを特徴とする請求 項3記載の錯体。

ウム系化合物と金属との錯体。

【化1】

$$(R^i)_h$$
 A
 $(R^i)_h$
 $(R^i)_h$
 $(R^i)_h$
 $(R^i)_h$
 $(R^i)_h$
 $(R^i)_h$

 において、R² とR³ が連結して炭素数2~4のア ルキレン基であり、R4 がフェニル基であることを特徴 とする請求項3記載の錯体。

【請求項7】 請求項1乃至6の何れかに記載の錯体を 含有することを特徴とする近赤外線吸収剤。

【請求項8】 透明基板上に、請求項1乃至6の何れか に記載の錯体を含有する層を有することを特徴とするブ ラズマディスプレイパネル用フィルター。

【請求項9】 電磁波カット層を設けることを特徴とす る請求項8記載のプラズマディスプレイパネル用フィル

【請求項10】 反射防止層を設けることを特徴とする 請求項8記載のプラズマディスプレイパネル用フィルタ

【請求項11】 ぎらつき防止層を設けることを特徴と する請求項8記載のプラズマディスプレイパネル用フィ ルター。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はスクアリリウム系化 合物の新規金属錯体及び、該錯体を用いる近赤外線吸収 剤或いはプラズマディスプレイパネル用フィルターに関 するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、近赤外線光を利用して情報データ を検知、読みとる技術の開発が進み、コードレスホーン 或いはリモートコントロール装置の様な身近な機器か ら、ロボットの駆動装置を始めとする各種自動制御装置 の開発が盛んに進められ、その技術は益々高精度化され つつある。これに伴い、他の装置或いは他場所から侵入 してくる近赤外線光による情報検知装置、読み取り装置 その他各種の計器類の誤動作によるトラブルも増加し、 医療分野等では、治療装置の誤動作から患者の生命が危 険に曝されることにもなる為、この様な近赤外線の遮蔽 技術の開発が要望されている。

【0003】一方、大型の壁掛けテレビを始め種々の電 子機器の表示パネルとしてプラズマディスプレイパネル が使用され、その需要は益々増大するものと考えられ る。しかしてプラズマディスプレイからは近赤外線光が 放射されるため、これを遮蔽しなければ、近赤外線を利 用した機器の近くでは使用できず、プラズマディスプレ イパネルの用途を大幅に狭めることとなる。そこで、特 ラズマディスプレイバネルから放射される近赤外線をカットするフィルターを提案している。しかして、赤外線 吸収色素であれば、全てプラズマディスプレイ用フィルターに使用し得るというものではない。プラズマディスプレイから放射される近赤外線をカットすると共に、ディスプレイの鮮明度を阻害する怖れのない色素であることが必要である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 本発明はプラズマディ スプレイパネル用フィルターにも好適に使用し得る近赤 外線吸収能を有する新しい化合物を提供することを目的

【発明の実施の形態】以下本発明につき詳細に説明す る。本発明に係わるスクアリリウム系化合物の金属錯体 は前記一般式(I)で示される。一般式(I)におい て、R1 、R1 ′ が置換基を有していても良いアルキル アミノ基或いはジアルキルアミノ基である場合のアルキ ル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、 オクチル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、ト リデシル基、ペンタデシル基等の炭素数1~20の直鎖 もしくは分岐鎖アルキル基が挙げられる。更にこれらア ルキル基が置換基として、ハロゲン原子、アルキルエー テル基、フェニル基、アルキルフェニル基、ハロ置換フ ェニル基、アルコキシフェニル基、ナフチル基、窒素原 子、硫黄原子などを含有する芳香族複素環基、アリール オキシ基、ハロ置換アリールオキシ基、アルコキシ置換 アリールオキシ基、シクロアルキル基、アルキル置換シ クロアルキル基、アルカノイルオキシ基を有する置換ア ルキル基が挙げられる。置換アルキル基の具体例として は、例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、 トリフルオロメチル基等のハロアルキル基:メトキシエ チル基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、ブト キシエチル基、メトキシエトキシエチル基、エトキシエ

とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は検討を重 本、特定の構造を有するスクアリリウム系化合物の新規 な舗体が上起目的を達成し得ることを知り事例を完成 した。即ち、本発明の要旨は、下記一般式(1)で表さ れるスクアリリウム系化合物と金属との舗体及びかかる 舗体を含有する近赤外線吸収剤並びにプラズマディスプ レイパネル用フィルターに存する。

[0006]

[化3]

ル基、4-エチルフェニル基、4-ブチルフェニル基等 のアルキル基で置換されたフェニル基、4-クロロフェ ニル基、4ーブロモフェニル基、4ーフルオロフェニル **基等のハロゲン原子で置換されたフェニル基、4ーメト** キシフェニル基、4-エトキシフェニル基、4-ブトキ シフェニル基、4-ヘキシルオキシフェニル基、4-オ クチルオキシフェニル基等のアルコキシ基で置換された フェニル基、ナフチル基、フリル基、チエニル基、ピリ ジル基等の窒素原子、イオウ原子等を含有していても良 い芳香族環等で置換されたアルキル基:フェニルオキシ 基、4-エチルフェニルオキシ基、4-ブチルフェニル オキシ基等のアルキル基で置換されたフェニルオキシ 基、4-クロロフェニルオキシ基、4-ブロモフェニル オキシ基、4-フルオロフェニルオキシ基等のハロゲン 原子で置換されたフェニルオキシ基、4-メトキシフェ ニルオキシ基、4-エトキシフェニルオキシ基、4-ブ トキシフェニルオキシ基、4-ヘキシルオキシフェニル オキシ基、4ーオクチルオキシフェニルオキシ基等のア ルコキシ基で置換されたフェニルオキシ基のアリールオ キシ基等で置換されたアルキル基;シクロヘキシル基、 4-エチルシクロヘキシル基、4-n-ブチルシクロヘ キシル基、4-tert-ブチルシクロヘキシル基等の アルキル基で置換されたシクロヘキシル基等のシクロア ルキル基で置換されたアルキル基:アセチルオキシ基、 ブチリルオキシ基、ヘキサノイルオキシ基、ノナノイル オキシ基等のアルカノイルオキシ基で置換されたアルキ ル基が挙げられる。

【0009】 R』 が置換基を有していても良いシクロア ルキルアミノ基におけるシクロアルキル基としては、シ クロヘキシル基、4-エテルシクロヘキシル基、4-n ーブチルシクロヘキシル基、4-tertープチルシク ロヘキシル基等のアルキル基で置換されたシクロアルキ ル基が挙げられる。置換基末1 が置換基を有していても ン基、プロポキシ基、ペンチルオキシ基、ペトラルオキシ基、ペキシルオキシ基、ペプチルオキシ基、オクテルオキシ 基等のアルコキシ基:メトキシエトキシ基、エトキシエトキシ エトキシエトキシエトキシ基、プトキシエトキシ 基、メトキシエトキシ基、プトキシエトキシ 基、メトキシエトキシ基、アトランド・ロールフリル オーシ基、フルフリルオキン基の様な5ないし6員環に より置換されたアルコキシ基:フルオロメトキシ基等のフルオコメトキシ基、プレフリルオーメート・シールフリルオキン基が分かる。プロメーロメトキシ基をのからなりなりなりなりない。

【0010】 X、X′は活性水素を有する基であり、具体的には、一〇H、一SH、一〇〇〇H、一SO3 H、一NHRち、一日(〇H)2、一PO(〇H)2 等が学げられる。 R⁵ は水素原子、 置換基を有していても良いフルキル基、 置換基を有していても良いフルキルカルボニル基、 置換基を有していても良いアルキルカルボニル基、 置換基を有していても良いアルキルスルボニル基まだはアリールスルボニル基を表し、これらの基における置換基を有していても良いアルキル基の具体例としては、R¹ で 例示したものと同様の基が学げられる。

【0011】R5 が置換基を有していても良いシクロア ルキル基の場合は、例えば、シクロヘキシル基、4-エ チルシクロヘキシル基、4-n-プチルシクロヘキシル 基、4-tert-ブチルシクロヘキシル基等のアルキ ル基で置換されたシクロヘキシル基及びシクロペンチル 基等が挙げられる。R5 が置換基を有していても良いア リールカルボニル基におけるアリール基及び置換基を有 していても良いアリールスルホニル基におけるアリール 基としては、例えば、フェニル基、4-エチルフェニル 基、4-ブチルフェニル基等のアルキル基で置換された フェニル基、4-クロロフェニル基、4-ブロモフェニ ル基、4-フルオロフェニル基等のハロゲン原子で置換 されたフェニル基、4ーメトキシフェニル基、4ーエト キシフェニル基、4ープトキシフェニル基、4ーヘキシ ルオキシフェニル基、4-オクチルオキシフェニル基等 のアルコキシ基で置換されたフェニル基、ナフチル基、 フリル基、チエニル基、ピリジル基等の窒素原子、イオ ウ原子等を含有していても良い芳香族環等が挙げられ る。

【0012】環へ、環Bとしては、例えば、ベンゼン 環、ナフタレン環等の芳香族茂素環或いは、例えば、ビ リジン環、キリン環、チアソール環、ベンソチアゾー ル環等の芳香族複素環が挙げられる。一般式(I)で示 されるスクアリリウム系化合物としては、環 及び環B が共にナフタレン環でX及びX、が一NHR5 であり RI、RI、が置換基を有していても良いアルキルアミ ノ基又はジアルキルアミノ基であることが好ましい。特 物が好ましい。 [0013] [化4] R² R² R⁴ H

[0014] (式中、R2、R3、R4は、それぞれ独立して、水素原子、置換差を有していても良いアルキル 素、置換差を有していても良いシクロアルキル基、置換 基を有していても良いアリール基又はヘテロアリール基 を表し、R2とR3 深いは尽ると内 は互いに連結して で又は5角の理又成いは尽ると内 は互いに連結して で又は5角の理又成のは同かりまかに

【0015】一般式 (II) において、R2、R3、R4 の具体例としては、それぞれ前述の、アルキル基、シク ロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基及びそれ らの置換体と同様の例が挙げられる。一般式(11)のス クアリリウム系化合物として好ましくは、R2 は水素原 子で、R3、R4 がアルキル基、或いはR3 とR4 が進 結して置換シクロアルキリデン基である化合物、R2 が 水素原子で、R³ 、R⁴ が置換基としてアリール基。ア リールオキシ基、アルカノイルオキシ基を有していても 良いアルキル基、アリール基またはフリル基から選ばれ る基である化合物或いはR2とR3が連結して炭素数2 ~4のアルキレン基であり、R4 がフェニル基である化 合物等である。スクアリリウム系化合物と錯体を形成す る金属としては、銅、コパルト、亜鉛、ニッケル等のキ レート能がある金属であれば特に限定されるものではな いが、好ましくは鋼である。

【0016】 本発明に係わる金属錯体は新規化合物であり、例えば、一般式(1)のスクアリリウム系化合物 製造される。金属ソースとしては、Cu、Co、Co、スn、Ni等のフッ素、臭素、塩素、ヨウ素等のハロゲン塩、半酸、酢糖等のカルボン酸量が挙げられ、好ましくはCu塩である。反応に使用される溶媒としては、メタノール、エタノール、ブタノール、メトキシエタノール、エトキシエタノール・エタアル、ブタノール、スターの大変を収集している。反応温度は宝温~100℃程度の範囲から選ばれる。反応温度は宝温~100℃程度の範囲から選ばれる。

【0017】また一般式(1)のスクアリリウム系化合物の1部は公知の化合物であり、例えば、特朗平10-36695号に記載されるように、スクアリック酸1-ルと対応する環状化合物2モルとを反応させることにより製造することができる。未発明にかかる新娘なスクア

領域に吸収を有し、半導体レーザー等を使用する光記録 媒体、液晶表示装置、光学文字読み取り機等における書 き込み又は終み取りの為の近赤外吸収色素、近赤外先増 感利、感熱転写、感熱紙、レーザー感熱印刷版に使用さ れる光熱変勢制あるいは光準電材料、腫瘍治療用感光性 色素、自動車用窓、建材用窓、農業用ハウス等に使用さ れる遮光剤として優れた効果を有するものである。

[0018]特にブラズマディスプレイバネル用フィルケーとして好適に使用される。ブラズマディスプレイバネル用フィルターは、透明基板に、木発明に低わる一般式(1)のスクアリリウム系化合物の金属錯体を含有する層を形成することにより容易に製造される。透明基板大きくない材料であれば特に制限はない。具体的な例としては、ガラス、ポリオレフィン系樹脂、非品質ポリオレフィン雑窟、ポリエステル系樹脂、ポリ、メリカーボネート系樹脂、ポリ、メリン、ポリ塩化ビニル、ポリアリレート樹脂、ポリエーデルサルホン樹脂等を挙げることができる。

【0019】これらの中では、特に非晶質ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリリカリのリル酸エステル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂等が好ましい。上記の樹脂には、一般的に公知である添加剤、例えばフェノール系、燐条などの酸化防止剤、バロゲン系、燐酸美等の難燃剤、耐熱を化防止剤、紫外線吸収剤、清剤、帯電防止剤等を配合することができる。

【0020】また上記機脂は、公知の射出成形、 Tダイ 成形、カレンダー成形、圧縮成形等の方法や有機溶剤に 溶膜させてキャスティングする方法などを用い、フィル ムまたはシート(板)等に飛形される。その厚みとして は、目的に配じて10μm・5mmの範囲が要ましい。 かかる透明基板を構成する基材は、未延伸でも延伸され ていても良い。また、他の基材と積層されていても良 い。

【0021】更に、該週期基板は、コロナ放電処理、火炎処理、プラズマ処理、グロ一放電処理、粗面化処理、 素処理場の使来公知の方法による表面処理や、アンカ ーコート剤やプライマー等のコーティングを施しても良い。本発明の金属錯体を含有する層は、フィルム或いは シート等に応形された週別基板上に、金属個体を含有する塗工液を差布することによって形成することができ る。塗工液は、金属錯体をバインダーと共に溶剤に溶解 させる方法、或いは、粒径の、1から3μに微粒化し た金属錯体を、必要に応じ分散剤を用い、バインダーと 上に溶剤に分散させる方法等により顕製される。塗工液 中に溶解又は分散される金属結体、バインダー、分散剤 等の固形分の量はの、5~50 重量%であり、固形分中 等の固形分の量は0、5~50 重量%であり、固形分中 くは1~50重量%である。

【0022】必要に応じて使用される分散剤としては、ボリビニルブチラール樹脂、フェノキシ樹脂、ロジン変性をフェノール樹脂、石油樹脂、保化ロジン、ロジンエステル、マレイン化ロジン、ポリウレタン樹脂等が学げられる。その使用量は、スクアリリウム系金属酸体に対して、0.5~100重量性、おましくは5~0重量をである。使用されるパインダーとしては、ポリメテルメタクリレート樹脂、ボリエチルアクリレート樹脂、ボリエチルアンリール・大量を機能、ボリエステル樹脂等が学げられる。その使用量はスクアリリウム系金属鍼体に対して、1~100重量を、好ましくは5~50重量をである。

【0023】盤工液に使用される溶剤としては、特に限定されるものではないが、例えばトルエン、キシレン等の方者族溶媒:メチルエチルトトン、シウロ・キサノン等のケトン系溶媒:エチレングリコールモノメチルエーテル、エテレングリコールモンメチルエーテル、エチレングリコール・ジメチルエーテル、エチレングリコール・ジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、不同に対して、アルエーテルス不良が使用される。

【0024】スクアリリウム系金属銭体を含む塗工液の コーティングは、ディッピング法、フローコート法、ス ブレー法、バーコート法、グラピアコート法、ロールコ ート法、ブレードコート法及びエアーナイフコート法等 の公知の塗工方法でコーティングされる。このとき乾燥 後の護厚が、0.1~30μm、好ましくは0.5~1 0μmとなるようコーティングされる。

【0025】本発明のプラズマディスプレイパネル用フィルターは、前記一般式(1)で表わされるスクアリリ ウム系金属器体を透明基板を構成する各種樹脂あるいは 他の樹脂に直接溶解あるいは分散させて、得られたスク アリリウム系金属器体を含有する樹脂を、射出成形、T ダイ成形、カレンダー成形あるいは圧縮成形などの成形 技術を用いて成形、フィルム化し、必要に応じて他の透 明基板と類り合わせて製造することもできる。

【0026】更に、前部建工港のコーティング法に代え 、前記一般式(1)で表わされるスクアリウム系金 属鍋体を透明落板を構成する樹脂シートあるいはフィル ムその他の樹脂シート(板)またはフィルムに染着さ と必要に応じて他の透明基板と張り合わせて設造する こともできる。また、フィルターの耐光性を上げるため にUV吸収剤を含有した透明樹脂層(UVカットフィル ム)を外側に指揮することもできる。

【0027】プラズマディスプレ―用の誤動作防止フィルターとして、ディスプレーから放射される近赤外線光をカットする目的でディスプレーの前面に設置するた

ることから、フィルターの可視光線の透過率は高い程度 く、少なくとも40%以上、好ましくは50%以上必要 である。

【0028】また、近赤外線光のカット領域は特に問題 になる波長としてリモコンや伝送系光通信に使用されて いる800~900nm、好ましくは、800~100 Onmであり、その領域の平均光線透過率が10%以下 になるように設計する。このために必要で有れば、上記 の一般式(!)で表されるスクアリリウム系金属錯体を 2種類以上組み合わせて用いることもできるし、他の近 赤外線吸収色素、例えば、ニトロソ化合物及びその金属 錯塩、シアニン系化合物、ジチオールニッケル錯塩系化 合物、フタロシアニン系化合物、トリアリルメタン系化 合物、イモニウム系化合物、ジイモニウム系化合物、ナ フトキノン系化合物、アントラキノン系化合物、アミノ 化合物、アミニウム塩系化合物、あるいは、カーボンブ ラックや、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ等 と組み合わせて使うこともできる。

【0029】本発明のプラズマディスプレイパネル用フ ィルターは、電磁波カット層を設けたり、表面への蛍光 灯などの外光の写り込みを防止する反射防止層、ぎらつ き防止(ノングレア)層を設けることができる。電磁波 カット層は、金属酸化物等の蒸着あるいはスパッタリン グ方法等が利用できる。通常は酸化インジウムスズ (I TO) が一般的であるが、誘電体層と金属層を基材上に 交互にスパッタリング等で積層させることで1000 n m以上の光をカットすることもできる。誘電体層として は酸化インジウム、酸化亜鉛などの透明な金属酸化物等 であり、金属層としては銀あるいは銀・パラジウム合金 が一般的である。通常、誘電体層よりはじまり3層、5 層、7層あるいは11層程度積層する。基材は、プラズ マディスプレイパネル用フィルターをそのまま利用して も良いし、樹脂フィルムあるいはガラス上に蒸煮あるい はスパッタリング後に、該フィルターと貼り合わせても 良い。

【0030】反射防止層は、表面の反射を抑えてフィル ターの透過率を向上させるために、金属酸化物、フッ化 物、ケイ化物、ホウ化物、炭化物、窒化物、硫化物等の 無機物を、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ ーティング法、イオンビームアシスト法等で単層あるい は多層に積層させる方法、アクリル樹脂、フッ素樹脂な どの屈折率の異なる樹脂を単層あるいは多層に積層させ る方法等がある。また、反射防止処理を施したフィルム を該フィルター上に貼り付けることもできる。

【0031】また、ノングレア層も設けることもでき る。ノングレア層は、フィルターの視野角を広げる目的 で、透過光を散乱させるために、シリカ、メラミン、ア クリル等の微粉体をインキ化して、フィルター表面にコ 一ティングする方法等を用いることができる。インキの 硬化は、熱硬化あるいは光硬化を用いることができる。 また、ノングレア処理をしたフィルムを該フィルター上 に貼り付けることもできる。更に必要であればハードコ 一ト層を設けることもできる。更に、このプラズマディ スプレイパネル用フィルターは単独はもちろん透明のガ ラスや他の透明樹脂板等と貼り合わせた種屋体として用 いることができる。

[0032]

【実施例】以下に実施例により本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の 実施例に制約されるものではない。

実施例1

一般式 (II) において、R² = H、R³ = R⁴ = C₂ H 5 で表されるスクアリリウム系化合物 1. 5 g (0.0 028モル)、塩化第一銅0、28g(0、0028モ ル)及び酢酸カリウムO、56gをエタノール100m Iに添加し、この混合液を室温で2時間撹拌後、濾過し て黒色の金属錯体 1、 4 g を得た。この化合物(金属錯 体1と称す)のNーメチルピロリドン中における最大吸 収波長は832nmであった。元素分析値から計算した 原子数(実測値)は、原料スクアリリウム化合物 4 モル とCu原子1モルの金属錯体として計算した原子数と、 下記の通り良く一致した。

[0033]

【表1】

原子数	С	н	N	Cu
計算值	136	136	16	1
実測値	136	134	16	1

【0034】実施例2

一般式 (II) において、R² = H、R³ = C H₃ 、R⁴ = C6 H₁₃ (n) で表されるスクアリリウム系化合物 1.5g(0.0026モル)、塩化第二銅0.35g (0.0026モル)及び酢酸カリウム0.51gをエ タノール100m | に添加し、この混合液を室温で2時 の化合物(金属錯体2と称す)のN-メチルピロリドン 中における最大吸収波長は844mmであった。元素分 析値から計算した原子数(実測値)は、原料スクアリリ ウム化合物5モルとCu原子1モルの金属錯体として計 算した原子数と、下記の通り良く一致した。

[0035]

原子数	С	н	N	Cu	
計算值	170	170	2 0	1	
実測値	172	168	20	1	

【0036】実施例3

実施例1で得られた金属錯体1を0.135g、ポリビ ニルブチラール樹脂2g及びポリメチルメタクリレート 樹脂3gをトルエンに溶解、分散して、固形分9重量% の塗工液を調製した。この塗工液を、ポリエチレンテレ フタレート製フィルム(ダイヤホイルヘキスト社製PE Tフィルム [T100E]、厚み100μm) に、パー コーター#20で塗工し、プラズマディスプレイパネル 用フィルターを得た。乾燥後の塗布膜厚は5 µmであっ た。このフィルターの近赤外線吸収の透過率を、日立分 光光度計(U-3500)で測定した。可視光線透過率 (TV) は75. 4% (JIS-R-3106に従って 計算)、800~900nmの平均透過率(TA)は 2. 0%であった。また、電気機器のリモートコントロ ール装置前面に、このフィルターを置き、電気機器の操 作を試みたが、電気機器は作動せず、リモートコントロ 一ル装置で使用される近赤外線が遮蔽されたことが確認 された。

【0037】実施例4

実施例2で得られた金属錯体2を4g、ポリビニルブチラール樹脂2g及びポリメチルメタクリレート樹脂3g

をトルエンに溶解、分散して、固形分9重量%の塗工液 を調製した。この塗工液を、実施例3と同種のボリーギン レンテレフタレート製フィルムに、バーコーダーギン で塗工し、プラズマディスプレイパネル用フィルターを 得た。乾燥後の塗布腹厚は5μmであった。このフィル ターの近赤外線吸収の透過率を、日立分光光度計(Uー 350)で測定した。可税光線透過率(「Y))は7 3.0%(J1S-R-3106に従って計算)、80 0~900mmの平均透過率(TA)は1.5%であった。

【0038】 室施例5~16

実施例1、2と同様にして、下記表-1に示すスクアリ リウム系化合物と、塩化第一級又は塩化第二銀を用い て、金属鉱体を合成し、実施例3、4と同様にしてブラ ズマディスプレイパネル用フィルターを作成し評価を行 ったところ、実施例3と同様に、近赤外線を遊蔵するこ とが確認された。得られたフィルターの透過率を表-1 に示した。

[0039] [表3]

.

			表 -	1			
実施例 Na.	一般式(11)のスクアリリウム系化合物			錯 体		フィルター	
	R 2	K2	R4	錯体の種類	最大吸収*1 波長(sm)	T y (%)	T, (%)
5	Н	C ₃ H ₇ (n)	C _S H ₇ (a)	実施例1型	832	74.8	2. 3
6	H	CH3	C4H9(a)	実施例1型	832	75.0	2.0
7	Н	CHS	C6H13(n)	実施例2型	844	73. 1	1.6
8	н	CH ₃	C3H6Ph	実施例1型	833	74.0	1.9
9	Н	CH3	C ₃ H ₆ Ph	実施例2型	845	72.8	1.4
10	Н	C ₄ H ₉ (n)	CH ₂ Ph	実施例1型	834	75. 3	1.9
11	Н	CH ₃	CH ₂ OPh	実施例1型	835	74.5	2.0
12	Н	CH2 0CO-C4 H9 (n)	CH2 OCO-C4 H9(n)	実施例1型	836	74.6	2.0
13	Н	C3H7(n)	Ph	実施例1型	835	75.6	1.8
14	Н	CH3	Fury1-2	実施例1型	835	75.0	1.8
15	Н	\times	C ₄ H ₉ (t)	実施例1型	836	75. 3	2.0
16		-(CH ₂) ₃ -	Ph	実施例1型	849	73. 2	1.8

*1: N-メチルピロリドン中での側定値 Ph: フェニル基

層を有する厚か3mmのポリメチルメタクリレート板 (三菱レーヨン社製アグリルフィルターMRーNG)の ノングレア層の形成されていない面と上記フィルターの ITの面を貼り合わせて、電磁波カット層及びぎらつき 防止層を有するブラズマディスプレイパネル用フィルター 一を作成した。実施例3と間様にリモートコントロール 装電を使用し、使用される近赤外線を遮蔽することを確 認した。

[0041]

【発明の効果】本発明に係るスクアリリウム系金属錯体 を含有する原を有するプラズマディスプレイパネル用フ ルターは、近赤外線遮蔽性能、可視光線透透性能、耐 光性に優れ、プラズマディスプレイが放射する近赤外線 を効率よくカットし、周辺の近赤外線を利用する装置類 の誤動作を引きおこすような悪影響を未然に防ぐことが できる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H048 CA04 CA12 CA19 CA24 CA27 CA29

> 2K009 AA02 AA12 AA15 BB24 CC02 CC09 CC24 CC26 DD01 DD03 DD04 DD06 DD07 EE03 4H048 AA01 AA03 AB92 VA00 VA20 VA30 VA32 VA40 VA45 VA56

> > VA66 VA75 VB10